

а 2004 0137

Изобретение относится к производству полупроводников, в частности к способам получения полупроводниковых наноструктур.

Сущность изобретения заключается в том, что способ получения полупроводниковых наноструктур включает осаждение маски на одну из поверхностей полупроводниковой пластинки, ионную имплантацию, электрохимическую обработку и удаление маски. Ионная имплантация осуществляется при энергии ионов до 30 keV и дозах не более  $10^{11}$  см<sup>-2</sup>, а электрохимическая обработка проводится при прохождении тока плотностью не менее 100 mA/cm<sup>2</sup>.

П. формулы: 1

Фиг.: 1